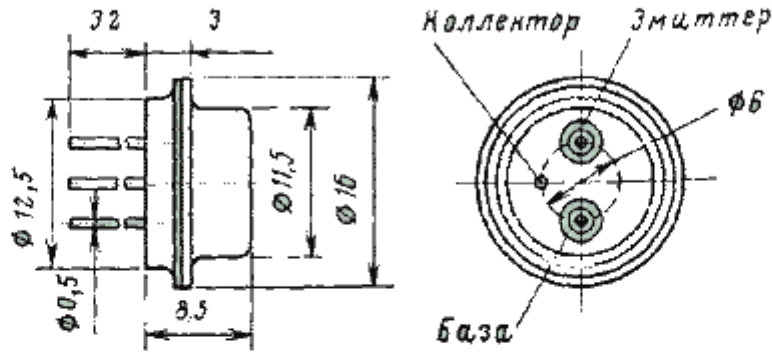


КТ801А, КТ801Б

Транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные *n-p-n* мощные. Предназначены для работы в схемах кадровой и строчной разверток, вторичных источниках питания.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 0,3$ А не менее	10 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 1$ А	
КТ801А	13—50
КТ801Б	30—150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А не более	2 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом не более	
КТ801А	
при $U_{КЭ} = 80$ В, $T_K = 233 - 298$ К	10 мА
при $U_{КЭ} = 40$ В, $T_K = 358$ К	20 мА
КТ801Б	
при $U_{КЭ} = 60$ В, $T_K = 233 - 298$ К	10 мА
при $U_{КЭ} = 30$ В, $T_K = 358$ К	20 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 2,5$ В не более	2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$ $\leq 100 \text{ Ом}$	
при $T_k = 233 - 328 \text{ К}$	
КТ801А	80 В
КТ801Б	60 В
при $T_k = 358 \text{ К}$	
КТ801А	40 В
КТ801Б	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	2,5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T_k = 233 - 328 \text{ К}$	5 Вт
при $T_k = 358 \text{ К}$	2 Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К